

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-186659  
 (43)Date of publication of application : 09.07.1999

(51)Int.CI.

H01S 3/18  
// H01L 33/00

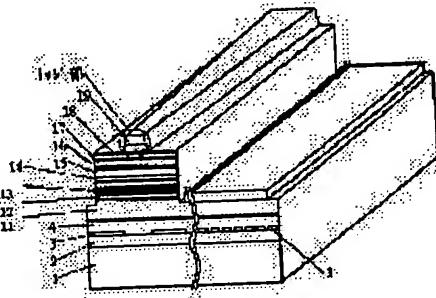
(21)Application number : 09-352540  
 (22)Date of filing : 22.12.1997

(71)Applicant : NICHIA CHEM IND LTD  
 (72)Inventor : YAMADA TAKAO  
 MATSUSHITA TOSHIO  
 NAKAMURA SHUJI

## (54) NITRIDE SEMICONDUCTOR LASER ELEMENT

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To oscillate a laser beam having a single NFP/FFP at a low threshold in a single mode for a long time.  
**SOLUTION:** A p-side clad layer 18 is composed of a super-lattice having a nitride semiconductor layer contg. at least Al with a ridge stripe formed on a part or entire part of the layer 18. At least one end width of the ridge stripe is formed narrow toward a resonance plane to make the horizontal transverse mode single. The total thickness of an n-side clad layer 13 composed of a super-lattice is set for 0.5  $\mu\text{m}$  or more and the mean Al composition of the clad layer 13 in percent is set so that the product of this composition (%) and total thickness ( $\mu\text{m}$ ) of the clad layer 13 is 4.4 or more, thereby making the vertical transverse mode single.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]	25.02.2000
[Date of sending the examiner's decision of rejection]	07.10.2002
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]	
[Date of final disposal for application]	
[Patent number]	
[Date of registration]	
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]	2002-21502
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]	06.11.2002
[Date of extinction of right]	

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-186659

(43)公開日 平成11年(1999)7月9日

(51)Int.Cl.  
H01S 3/18  
// H01L 33/00

識別記号

F I  
H01S 3/18  
H01L 33/00

C

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全9頁)

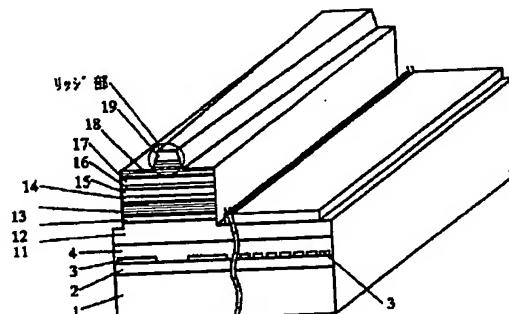
(21)出願番号 特願平9-352540  
(22)出願日 平成9年(1997)12月22日

(71)出願人 000226057  
日亜化学工業株式会社  
徳島県阿南市上中町岡491番地100  
(72)発明者 山田 奉夫  
徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化  
学工業株式会社内  
(72)発明者 松下 俊雄  
徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化  
学工業株式会社内  
(72)発明者 中村 修二  
徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化  
学工業株式会社内

(54)【発明の名称】 穴化物半導体レーザ素子

(57)【要約】

【目的】 単一のNFP、FFPを有し、低閾値でシングルモードのレーザ光を長時間発振させる。  
【構成】 p側クラッド層は少なくともA1を含む窒化物半導体層を有する超格子よりなり、そのp側クラッド層の一部、若しくは全部に前記リッジストライプが形成されており、さらにそのリッジのストライプ幅の少なくとも一方が共振面に接近するに従って狭くなるように形成されていることにより水平横モードをシングルにすると共に、超格子となるn側クラッド層全体の厚さを0.5μm以上として、n側クラッド層に含まれるA1平均組成を百分率(%)で表した際に、n側クラッド層全体の厚さ(μm)とA1平均組成(%)との積が4.4以上となるように構成することにより垂直横モードをシングルにする。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にn側クラッド層と、活性層と、p側のクラッド層とを順に有し、活性層よりも上の層に、対向する共振面に対してほぼ垂直なリッジストライプを有する窒化物半導体レーザ素子において、前記p側クラッド層は少なくともA1を含む窒化物半導体層を有する超格子よりなり、そのp側クラッド層の一部、若しくは全部に前記リッジストライプが形成されており、さらにそのリッジのストライプ幅の少なくとも一方が共振面に接近するに従つて狭くなるように形成されていることを特徴とする窒化物半導体レーザ素子。

【請求項2】 前記リッジストライプは、レーザ出力側のストライプ幅が全反射側のストライプ幅よりも狭くされてなることを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体レーザ素子。

【請求項3】 前記n側クラッド層は、少なくともA1を含む窒化物半導体層を有する超格子よりなり、そのn側クラッド層全体の厚さが0.5μm以上で、かつそのn側クラッド層に含まれるA1平均組成を百分率(%)で表した際に、n側クラッド層全体の厚さ(μm)とA1平均組成(%)との積が4.4以上となるように構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の窒化物半導体レーザ素子。

【請求項4】 前記p側クラッド層全体の厚さが2.0μm以下であり、かつそのp側クラッド層に含まれるA1平均組成を百分率(%)で表した際に、p側クラッド層全体の厚さ(μm)とA1平均組成(%)との積が4.4以上となるように構成されていることを特徴とする請求項1乃至3の内のいずれか1項に記載の窒化物半導体レーザ素子。

【請求項5】 前記n側とp側のクラッド層との間にある活性層を含んだ窒化物半導体層の厚さが200オングストローム以上、1.0μm以下の範囲にあることを特徴とする請求項1乃至4の内のいずれか1項に記載の窒化物半導体レーザ素子。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は窒化物半導体( $In_xAl_{1-x}Ga_yN$ ,  $0 \leq a, 0 \leq b, a+b \leq 1$ )よりなるレーザ素子に関する。

## 【0002】

【従来の技術】我々は窒化物半導体基板の上に、活性層を含む窒化物半導体レーザ素子を作製して、世界で初めて室温での連続発振1万時間以上を達成したことを発表した(ICNS'97予稿集, October 27-31, 1997, P444-446、及びJpn. J. Appl. Phys. Vol. 36(1997) pp. L1568-1571, Part 2, No. 12A, 1 December 1997)。図8はそのレーザ素子の構造を示す模式的な断面図である。基本的な構造としてはサファイア基板上に、ストライプ状に形成されたSiO<sub>2</sub>膜を介して選択成長されたn-GaNよりなる窒

化物半導体基板の上に、レーザ素子構造となる窒化物半導体層が複数積層されてなる。(詳細はJpn. J. Appl. Phys. Vol. 36参照)

【0003】 基本的なレーザ素子構造は、In<sub>0.02</sub>Ga<sub>0.98</sub>Nよりなる障壁層と、In<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nよりなる井戸層とが積層された活性層を、n-Al<sub>0.14</sub>Ga<sub>0.86</sub>N/GaNとからなる超格子構造のn側クラッド層と、p-Al<sub>0.14</sub>Ga<sub>0.86</sub>N/GaNとからなる超格子構造のp側クラッド層とで挟んだダブルヘテロ構造を有する。超格子を構成する単一窒化物半導体層の膜厚はそれぞれ25オングストロームである。さらにp型クラッド層の一部から上には同一ストライプ幅のリッジが形成されている。活性層の発光はリッジストライプの下にある導波路領域に集中し、共振面間で共振して、レーザとなって出射される。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のレーザ素子ではレーザ光がマルチモードになりやすい傾向にあった。水平横モードはリッジストライプを狭くすることによりシングルモード化が図られているが、シングルモードを得るためにストライプ幅を狭くすると、リッジストライプの上に形成するオーミック電極の形成が難しくなる傾向にある。また電極面積も小さくなるために、微小部分に電流が集中することにより、レーザ素子の閾値が上昇したり、また発熱により素子自体の信頼性が低くなる。

【0005】一方垂直横モードでは、両クラッド層による光の閉じ込めが未だ不十分な傾向にある。例えばn側クラッド層から漏れた光は、屈折率が小さいサファイア基板で反射し、基板とn側クラッド層の間にある屈折率が大きいGaN層中で導波する。そのGaN層中で導波した光は、活性層端面から出射されるレーザ光と重なり合いファーフィールドパターン(FFP)の形状を乱し、例えば出射されるレーザ光のスポットが複数となつて現れ、マルチモードとなって観測される。マルチモードのレーザ素子はピックアップ用光源として使用するには非常に使いにくい。

【0006】従つて本発明の目的とするところは、窒化物半導体レーザ素子を各種光源として使用するため、单一モードのNFP、FFPを有し、低閾値でレーザ光を長時間発振させることにある。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明の窒化物半導体レーザ素子は、基板上にn側クラッド層と、活性層と、p側のクラッド層とを順に有し、活性層よりも上の層に、対向する共振面に対してほぼ垂直なリッジストライプを有する窒化物半導体レーザ素子において、前記p側クラッド層は少なくともA1を含む窒化物半導体層を有する超格子よりなり、そのp側クラッド層の一部、若しくは全部に前記リッジストライプが形成されており、さらに

50 全部に前記リッジストライプが形成されており、さらに

そのリッジのストライプ幅の少なくとも一方が共振面に接近するに従って狭くなるように形成されていることを特徴とする。

【0008】さらに、前記リッジストライプは、出力側のストライプ幅が全反射側のストライプ幅よりも狭くされなることを特徴とする。なおレーザの出力側、全反射側は、例えば共振面に形成する反射膜の反射率を調整することにより適宜決定することができる。

【0009】また、本発明のレーザ素子では、前記n側クラッド層は、少なくともA1を含む窒化物半導体層を有する超格子よりなり、そのn側クラッド層全体の厚さが0.5μm以上で、かつそのn側クラッド層に含まれるA1平均組成を百分率(%)で表した際に、n側クラッド層全体の厚さ(μm)とA1平均組成(%)との積が4.4以上となるように構成されていることを特徴とする。

【0010】さらに、前記p側クラッド層全体の厚さが2.0μm以下であり、かつそのp側クラッド層に含まれるA1平均組成を百分率(%)で表した際に、p側クラッド層全体の厚さ(μm)とA1平均組成(%)との積が4.4以上となるように構成されていることを特徴とする。

【0011】さらにまた本発明のレーザ素子において、前記n側とp側のクラッド層との間にある活性層を含んだ窒化物半導体層の厚さが200オングストローム以上、1.0μm以下の範囲にあることを特徴とする。

#### 【0012】

【発明の実施の形態】本発明のレーザ素子において、クラッド層とは、屈折率が活性層の井戸層よりも小さい窒化物半導体を含む光閉じ込め層である。また超格子とは単一層の膜厚が100オングストローム以下で、互いに組成が異なる窒化物半導体層を積層した多層膜構造を指し、好ましくは70オングストローム以下、さらに好ましくは40オングストローム以下の膜厚の窒化物半導体層を積層する。具体的な構成としては、例えばA1xGa<sub>1-x</sub>N(0 < x < 1)層と、そのA1xGa<sub>1-x</sub>N層と組成が異なる他の窒化物半導体層とを積層した超格子とし、例えばA1xGa<sub>1-x</sub>N/GaN、A1xGa<sub>1-x</sub>N/A1yGa<sub>1-y</sub>N(0 < Y < 1, Y < X)、A1xGa<sub>1-x</sub>N/I<sub>n</sub>zGa<sub>1-z</sub>N(0 < Z < 1)等の3元混晶と3元混晶、若しくは3元混晶と2元混晶との組み合わせで超格子とすることができます。その中でも最も好ましくはA1xGa<sub>1-x</sub>NとGaNとからなる超格子とする。これは、n側クラッド層を超格子とする場合も同様である。なおクラッド層と、活性層とは接して形成されていくても良いことは言うまでもない。

【0013】図1は本発明のレーザ素子の形状を示す模式的な斜視図であり、同時に積層構造も示している。また図2は、図1のレーザ素子をリッジ側から見た平面図である。このレーザ素子は、超格子よりなるp側クラッ

ド層18の一部にリッジストライプが形成され、そのリッジのストライプ幅の一方が共振面に接近するに従って狭くなるように形成され、もう一方のストライプ幅が共振面に接近するに従って広くなるように形成されている。

【0014】このように、好ましくはリッジの出力側のストライプ幅を狭くし、もう一方の全反射側を広くすることにより、リッジ下部のレーザ光は、ストライプ幅の狭いところで水平横モードがシングルモードとなる。一方、ストライプ幅の広い所はそのリッジ下部でマルチモードとなる可能性があるが、狭い部分すでにシングルとなっているため、導波光が共振面間で共振している間に、広いところのマルチモードは狭い部分で減衰してしまうので、結局、ストライプ幅の広い部分に対応した共振面から出るレーザ光もシングルモードとなる。また、リッジのストライプ幅が次第に狭くなっている部分と、次第に広くなっている部分とがあるために、表面積は等間隔でストライプ幅を設けたものとほぼ同等であるか、若しくは実質的に広くできるために、狭い領域に電流が集中せず、リッジ均等に流れると、素子自体の発熱も少くなり信頼性も良くなる。

【0015】図4はリッジの形状を示す平面図であり、図2と異なりn電極は省略している。この図で説明すると、ストライブリッジを形成する場合、出力側のストライプ幅aは、0.5μm～5μm、さらに好ましくは1μm～2μmの範囲に調整することが望ましい。0.5μmよりも狭くすると、そのクラッド層の上に積層されるコンタクト層のリッジ幅も同様に狭くなるため、オーミック用のp電極を形成するのが難しくなる傾向にある。一方、全反射側のストライプ幅bは、2μm～20μm、さらに好ましくは、4μm～6μmの範囲に調整することが望ましい。2μmよりも狭くすると、もう一方のストライプ幅aも2μmよりも狭くせざるを得ない。そのため全体のリッジ幅が狭くなりすぎて、電流がリッジに集中しすぎて、素子が発熱しやすい傾向にある。一方、20μmよりも広いと、リッジ下部での光のロスが大きく出力が低下しやすい傾向にある。

【0016】また、リッジのストライプ形状は図4に示すように途中で「くびれ」が無く、一定の角度でいずれか一方の方に狭くなっていることが最も好ましい。本発明ではその角度はできるだけ小さい方が望ましい。例えばレーザの共振方向に水平な方向に対しての、角度θは10°以内、さらに好ましくは8°以内、最も好ましくは5°以内に調整する。角度が急になると、その急になった部分から外部に光が漏れてリッジ下部に光が集中しにくいために、レーザとしての効率が悪くなり、出力が低下して、閾値が上昇しやすい傾向にある。そのため本発明ではできるだけ緩やかな角度で端面に接近するにつれて次第に狭くなったリッジストライプを形成し、狭い方を出力側とし、広い方を全反射側とする方が望まし

い。好ましいリッジストライプとしては出力側 $a$ を1～3 μm、全反射側を3～8 μmとして、傾斜角を3°以内としたリッジストライプを形成することが最も好ましい。

【0017】図5～図7は本発明に係る他のリッジストライプの形状を示す平面図である。本発明では図5～図6に示すように、両方のリッジストライプ幅も共振面に接近するに従って狭くなるように形成されていても良い。また、図7のようにストライプの中間に、共振面に接近するに従って一方が狭くなり、もう一方が広くなるような形状を有していても良い。但し、図5～図7に示すように、広いストライプ幅から急激に狭くすると、前記角度θが大きくなつて、そのくびれ部分から光が漏れやすくなつて、レーザの出力が低くなる傾向にある。従つて、図5～図7のようなリッジストライプを形成する際においても、その傾斜角は10°以内に調整することが望ましい。

【0018】さらにまた本発明では、n側クラッド層は、少なくともA1を含む窒化物半導体層を有する超格子よりもなり、そのn側クラッド層全体の厚さが0.5 μm以上で、かつそのn側クラッド層に含まれるA1平均組成を百分率(%)で表した際に、n側クラッド層全体の厚さ(μm)とA1平均組成(%)との積が4.4以上となるように構成することにより、垂直横モードのレーザ光が制御でき、シングルモードとなりやすい。n側クラッド層の厚さが0.5 μmよりも薄く、かつそのn側クラッド層全体の厚さ(μm)とA1平均組成(%)との積が4.4よりも少ないと、n側クラッド層としての光閉じ込めが不十分となり、n側のコンタクト層で導波して、FFPが乱れ、閾値も上昇する傾向にある。好ましい積の値としては5.0以上、さらに好ましくは5.4以上にする。ベストモードとしては7以上に調整する。

【0019】例えば、前記n側クラッド層の全体の厚さを0.8 μm以上とし、前記n側クラッド層に含まれるA1平均組成を5.5%以上とする。この場合の積は4.4以上である。好ましくはn側クラッド層の全体の厚さを1.0 μm以上とし、そのn側クラッド層に含まれるA1平均組成を5.0%以上とする。この場合の積は5.0以上である。さらに好ましくは、n側クラッド層の全体の厚さを1.2 μm以上とし、そのn側クラッド層に含まれるA1平均組成を4.5%以上とする。この場合の積は5.4以上である。これはn側クラッド層の膜厚の関係と、超格子よりもn側クラッド層のA1平均組成の関係を具体的に示すものである。

【0020】またp側クラッド層についても、p側クラッド層全体の厚さを2.0 μm以下とし、かつそのp側クラッド層に含まれるA1平均組成を百分率(%)で表した際に、p側クラッド層全体の厚さ(μm)とA1平均組成(%)との積が4.4以上となるように構成する

こともできる。この構成により垂直横モードのレーザ光が制御できて、シングルモードとなりやすい。なお、p側クラッド層よりも、特にn側クラッド層を前記構成とすることが望ましい。なぜなら、p側クラッド層に関しては、本願のような形状のリッジストライプとして、その上に電極を設けるため、電極で光が吸収されるために、垂直横モードの光の漏れがあつてもほとんど無視できるからである。

【0021】但し、p側クラッド層を以上のような構成とすると、そのp側クラッド層の膜厚はn側クラッド層よりも薄くすることが望ましい。なぜなら、p側クラッド層のA1平均組成を大きくするか、若しくは膜厚を厚くすると、A1GaN層の抵抗値が大きくなる傾向があり、A1GaNの抵抗値が大きくなると、駆動電圧が高くなる傾向にあるからである。好ましい膜厚としては、1.5 μm以下、さらに好ましくは1 μm以下にする。下限については特に限定しないが、クラッド層として作用させるためには、50オングストーム以上の膜厚があることが望ましく、また、A1の平均組成としては50%以下が望ましい。

【0022】一般に、A1xGa1-xNはA1混晶比を大きくするに従い、バンドギャップエネルギーが大きくなり、屈折率も小さくなることが知られている。理想的にはA1混晶比Xの大きい、例えば0.5以上のA1xGa1-xN層を、単一層で例えば数μmの膜厚で成長させることができれば、工業的にも都合がよいのであるが、A1xGa1-xNは厚膜で成長させにくい。単一層で特にA1混晶比が0.5以上のA1xGa1-xNを成長させようとすれば、例えば0.1 μm以上で結晶中にクラックが入ってしまう。ところが本発明のようにA1xGa1-xNを超格子を構成するような薄膜とすると、単一膜厚がA1xGa1-xNの臨界限界膜厚以下となるので、クラックが入りにくい。そのためクラッド層を超格子とするとA1混晶比の高い層でも厚膜で成長できるようになり、それらを組み合わせることにより、光をn側のクラッド層から基板側に漏れないようにすることができる。

【0023】本発明において、超格子におけるA1平均組成は、以下のような算出方法で求めるものとする。例えば25オングストロームのA10.5Ga0.5Nと、25オングストロームのGaNとを200ペア(1.0 μm)積層した超格子の場合、1ペアが50オングストローム、A1を含む層のA1混晶比が0.5であるため、0.5(25/50)=0.25となり、超格子におけるA1平均組成は25%である。一方、膜厚が異なる場合、A10.5Ga0.5Nを40オングストロームと、GaNを20オングストロームとで積層した場合、膜厚の加重平均を行い、0.5(40/60)=0.33となり、A1平均組成は33.3%とする。即ちA1を含む窒化物半導体層のA1混晶比、その窒化物半導体層が超格子1ペアの膜厚に占める割合に乘じたものを本発明

における超格子のA1平均組成とする。またA1を両方含む場合も同様であり、例えば $A_{10.1}Ga_{0.9}N$ 20オングストローム、 $A_{10.2}Ga_{0.8}N$ 30オングストロームの場合も、 $0.1(20/50) + 0.2(30/50) = 0.16$ 、即ち16%をA1平均組成とする。なお以上の例は $AlGaN/GaN$ 、 $AlGaN/AlGaN$ について説明したが、 $AlGaN/InGaN$ についても同じ算出方法を適用するものとする。従って、n側クラッド層を成長させる場合には、以上の算出方法に基づいて成長方法を設計できる。また、n側クラッド層のA1平均組成は、SIMS（二次イオン質量分析装置）、オージェ等の分析装置を用いても検出できる。

## 【0024】

【実施例】【実施例1】図1～図3に基づき実施例1について説明する。図3は図1のレーザ素子にp電極を形成した後の構造を示す模式断面図であり、図1～図3において同一符号で示されている箇所は同一箇所を示している。

【0025】（下地層2）2インチ $\phi$ 、C面を正面とするサファイアよりなる異種基板1をMOVPE反応容器内にセットし、温度を500℃にして、トリメチルガリウム(TMГ)、アンモニア( $NH_3$ )を用い、 $GaN$ よりなるバッファ層（図示せず）を200オングストロームの膜厚で成長させる。バッファ層成長後、温度を1050℃にして、同じく $GaN$ よりなる下地層2を4μmの膜厚で成長させる。この下地層2は保護膜を部分的に表面に形成して、次に窒化物半導体基板の選択成長を行うための下地層として作用する。下地層2はA1混晶比X値が0.5以下の $Al_xGa_{1-x}N$  ( $0 \leq x \leq 0.5$ )を成長させることが望ましい。0.5を超えると、結晶欠陥というよりも結晶自体にクラックが入りやすくなってしまうため、結晶成長自体が困難になる傾向にある。また膜厚はバッファ層よりも厚い膜厚で成長させて、10μm以下の膜厚に調整することが望ましい。基板はサファイアの他、 $SiC$ 、 $ZnO$ 、スピネル、 $GaAs$ 等、窒化物半導体を成長するために知られている、窒化物半導体と異なる材料よりなる基板を用いることができる。

【0026】（保護膜3）下地層2成長後、ウェーハを反応容器から取り出し、この下地層2の表面に、ストライプ状のフォトマスクを形成し、CVD装置によりストライプ幅10μm、ストライプ間隔（窓部）2μmの $SiO_2$ よりなる保護膜3を1μmの膜厚で形成する。保護膜の形状としてはストライプ状、ドット状、基盤目状等どのような形状でも良いが、窓部よりも保護膜の面積を大きくする方が、結晶欠陥の少ない第2の窒化物半導体層3が成長しやすい。保護膜の材料としては、例えば酸化ケイ素( $SiO_x$ )、窒化ケイ素( $Si_xNy$ )、酸化チタン( $TiO_x$ )、酸化ジルコニウム( $ZrO_x$ )等の酸化物、窒化物、またこれらの多層膜の他、1200

℃以上の融点を有する金属等を用いることができる。これらの保護膜材料は、窒化物半導体の成長温度600℃～1100℃の温度にも耐え、その表面に窒化物半導体が成長しないか、若しくは成長しにくい性質を有している。

【0027】（窒化物半導体基板4）保護膜3形成後、ウェーハを再度MOVPEの反応容器内にセットし、温度を1050℃にして、TMГ、アンモニアを用い、アンドープ $GaN$ よりなる $GaN$ よりなる窒化物半導体基板4を20μmの膜厚で成長させる。成長後の窒化物半導体基板4の表面は、保護膜のストライプ中央部と、窓部のストライプ中央部にはストライプ状の保護膜と平行に結晶欠陥が表出していたが、後にレーザ素子のリッジ形成時に、リッジストライプがこの結晶欠陥に係らないようにすることにより、活性層に結晶欠陥が転位せず、素子の信頼性が向上する。窒化物半導体基板4はハイドロ気相成長法(HVPE)を用いて成長させることができる。このようにMOVPE法により成長させることもできる。窒化物半導体基板はIn、A1を含まない $GaN$ を成長させることが最も好ましく、成長時のガスとしては、TMГの他、トリエチルガリウム(TEG)等の有機ガリウム化合物を用い、窒素源はアンモニア、若しくはヒドラジンを用いることが最も望ましい。また、この $GaN$ 基板に $Si$ 、 $Ge$ 等のn型不純物をドープしてキャリア濃度を適当な範囲に調整してもよい。特に異種基板1、下地層2、保護膜3を除去する場合には、窒化物半導体基板がコンタクト層となるため、この窒化物半導体基板4にn型不純物をドープすることが望ましい。

【0028】（n側バッファ層11=兼n側コンタクト層）次に、アンモニアとTMГ、不純物ガスとしてシリカガスを用い、第2の窒化物半導体層4の上に $Si$ を $3 \times 10^{18}/cm^3$ ドープした $GaN$ よりなるn側バッファ層11を5μmの膜厚で成長させる。このバッファ層は、図1のような構造の発光素子を作製した場合にはn電極を形成するためのコンタクト層として作用する。また異種基板1～保護膜3を除去して、窒化物半導体基板4に電極を設ける場合には、省略することもできる。このn側バッファ層11は高温で成長せるバッファ層であり、例えばサファイア、 $SiC$ 、スピネルのように窒化物半導体と異なる材料よりなる基板の上に、900℃以下の低温において、 $GaN$ 、 $AlN$ 等を、0.5μm以下の膜厚で直接成長させるバッファ層とは区別される。

【0029】（クラック防止層12）次に、TMГ、TMI（トリメチルインジウム）、アンモニアを用い、温度を800℃にして $In_{0.06}Ga_{0.94}N$ よりなるクラック防止層12を0.15μmの膜厚で成長させる。

【0030】（n側クラッド層13=超格子層）続いて、1050℃でTMA、TMГ、アンモニア、シリカガスを用いて、 $In_{0.06}Ga_{0.94}N$ よりなるクラック防止層12を0.15μmの膜厚で成長させる。

ガスを用い、Siを $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ ドープしたn型A<sub>10.16</sub>G<sub>a0.84</sub>Nよりなる第1の層を25オングストロームの膜厚で成長させ、続いてシランガス、TMAを止め、アンドープのGaNよりなる第2の層を25オングストロームの膜厚で成長させる。そして第1層+第2層+第1層+第2層+...というように超格子層を構成し、総膜厚1.2μmの超格子よりなるn側クラッド層13を成長させる。この超格子よりなるn側クラッド層はA1平均組成が8.0%であるので、その膜厚との積は9.6となる。なおn側クラッド層に、バンドギャップエネルギーが異なる窒化物半導体を積層した超格子を作製した場合、不純物はいずれか一方の層に多くドープして、いわゆる変調ドープを行うと閾値が低下しやすい傾向にある。

【0031】(n側光ガイド層14) 続いて、シランガスを止め、1050°CでアンドープGaNよりなるn側光ガイド層14を0.1μmの膜厚で成長させる。このn側光ガイド層は、活性層の光ガイド層として作用し、GaN、InGaNを成長させることができると望ましく、通常100オングストローム～5μm、さらに好ましくは200オングストローム～1μmの膜厚で成長させることができると望ましい。

【0032】(活性層15) 次に、TMG、TMI、アンモニアを用い活性層14を成長させる。活性層は温度を800°Cに保持して、アンドープIn<sub>0.2</sub>G<sub>a0.8</sub>Nよりなる井戸層を40オングストロームの膜厚で成長させる。次にTMIのモル比を変化させるのみで同一温度で、アンドープIn<sub>0.01</sub>G<sub>a0.99</sub>Nよりなる障壁層を100オングストロームの膜厚で成長させる。井戸層と障壁層を順に積層し、最後に障壁層で終わり、総膜厚440オングストロームの多重量子井戸構造(MQW)の活性層を成長させる。活性層は本実施例のようにアンドープでもよいし、またn型不純物及び/又はp型不純物をドープしても良い。不純物は井戸層、障壁層両方にドープしても良く、いずれか一方にドープしてもよい。

【0033】(p側キャップ層16) 次に、温度を1050°Cに上げ、TMG、TMA、アンモニア、Cp2Mg(シクロペンタジエニルマグネシウム)を用い、p側光ガイド層17よりもバンドギャップエネルギーが大きい、Mgを $1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ ドープしたp型A<sub>10.3</sub>G<sub>a0.7</sub>Nよりなるp側キャップ層16を300オングストロームの膜厚で成長させる。このp型キャップ層16は0.1μm以下の膜厚で形成することにより素子の出力が向上する傾向にある。膜厚の下限は特に限定しないが、10オングストローム以上の膜厚で形成することができると望ましい。

【0034】(p側光ガイド層17) 続いてCp2Mg、TMAを止め、1050°Cで、バンドギャップエネルギーがp側キャップ層16よりも小さい、アンドープGaNよりなるp側光ガイド層17を0.1μmの膜厚

で成長させる。この層は、活性層の光ガイド層として作用し、n型光ガイド層14と同じくGaN、InGaNで成長させることができると望ましい。

【0035】(p側クラッド層18) 続いて、1050°CでMgを $1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ ドープしたp型A<sub>10.16</sub>G<sub>a0.84</sub>Nよりなる第3の層を25オングストロームの膜厚で成長させ、続いてTMAのみを止め、アンドープGaNよりなる第4の層を25オングストロームの膜厚で成長させ、総膜厚0.6μmの超格子層よりなるp側クラッド層18を成長させる。このp側クラッド層もA1の平均組成が8%であるので、膜厚との積は4.8となる。なお、p側クラッド層も少なくとも一方がA1を含む窒化物半導体層を含み、互いにバンドギャップエネルギーが異なる窒化物半導体層を積層した超格子で作製した場合、不純物はいずれか一方の層に多くドープして、いわゆる変調ドープを行うと閾値が低下しやすい傾向にある。

【0036】ここで、クラッド層で挟まれたコア部分(導波部分)の膜厚について述べる。コア部分とは、n側光ガイド層14、活性層15、p側キャップ層16、及びp側光ガイド層17を合わせた領域、即ちn側クラッド層と、p側クラッド層との間にある活性層を含む窒化物半導体層を指し、活性層の発光を導波する領域である。窒化物半導体レーザ素子の場合、FFPが单一ビームとならないのは、先にも述べたように、クラッド層から漏れた発光がn側のコンタクト層内で導波してマルチモードになるからである。その他、コア内で共振することによってマルチモードになる場合がある。本発明ではまずn側のクラッド層の膜厚を厚くして、A1平均組成を大きくすることにより、屈折率差を設け、コア内の光をクラッド層で閉じ込めるものである。しかし、コア内でマルチモードができると、FFPは乱れる。そのため、本発明のn側クラッド層との関係において、コア内でマルチモードにならないようにするために、このコア部分の厚さも調整する方が望ましい。コア部分にマルチモードが発生しないようにするための好ましい厚さとしては、200オングストローム以上、1.0μm以下、さらに好ましくは500オングストローム～0.8μm、最も好ましくは0.1μm～0.5μmの範囲に調整することが望ましい。200オングストロームよりも薄いと、コア部分から光が漏れだし、閾値が上昇する傾向にある。また1.0μmよりも厚いとマルチモードになりやすい傾向にある。

【0037】(p側コンタクト層19) 最後に、1050°Cで、p側クラッド層18の上に、Mgを $2 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ ドープしたp型GaNよりなるp側コンタクト層18を150オングストロームの膜厚で成長させる。p側コンタクト層19はp型のIn<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>G<sub>a1-x-y</sub>N( $0 \leq x, y, x+y \leq 1$ )で構成することができ、好みやすくはMgをドープしたGaNとすれば、p電極21

と最も好ましいオーミック接触が得られる。

【0038】以上のようにして窒化物半導体を成長させたウェーハを反応容器において、窒素雰囲気中700°Cでアニーリングを行い、p型不純物をドープした層をさらに低抵抗化させる。

【0039】アニーリング後、ウェーハを反応容器から取り出し、RIE装置により最上層のp側コンタクト層18と、p側クラッド層17の一部とをエッチングして、図1、及び図2に示すような形状のリッジストライプを形成する。このリッジストライプは片方の共振面側のストライプ幅を2.0μmに設定し、もう片方の共振面側のストライプ幅を4.0μmに設定しており、共振器長を500μmに設定することにより、レーザ共振方向に対する角度θを3°以下にしている。なお、本実施例ではp側クラッド層の一部をリッジストライプとしているが、エッチング深さを深くして、p側クラッド層の全部をリッジストライプとすることもできる。

【0040】また、リッジストライプを形成する際、そのリッジストライプは、窒化物半導体基板の表面に結晶欠陥が現れていない位置に形成する。結晶欠陥はストライプ状の保護膜3中央部、及びストライプ状の窓部中央部に現れやすい傾向にある。そのためその中央部を避けてリッジストライプを形成することにより、結晶欠陥が活性層まで伸びてこなくなる傾向にあるため、素子を長寿命とることができ、信頼性が向上する。

【0041】次にリッジ表面にマスクを形成し、RIEにてエッチングを行い、n側バッファ層11の表面を露出させる。露出させたこのn側バッファ層11はn電極23を形成するためのコンタクト層としても作用する。

【0042】次にp側コンタクト層19のリッジ最表面にNiとAuよりなるp電極20をストライプ状に形成し、一方、TiとAlよりなるn電極22を先ほど露出させたn側バッファ層11の表面にストライプ状に形成した後、図3に示すようにp電極20と、n電極22との間に露出した窒化物半導体層の表面にSiO<sub>2</sub>よりなる絶縁膜23を形成し、この絶縁膜23を介してp電極20と電気的に接続したpバッド電極21を形成する。pバッド電極はp層側に漏れる光を吸収する。

【0043】以上のようにして、n電極とp電極とを形成したウェーハのサファイア基板を研磨して70μmとした後、ストライプ状の電極に垂直な方向で、基板側からバー状に劈開し、劈開面に共振器を作製する。共振器面にSiO<sub>2</sub>とTiO<sub>2</sub>よりなる誘電体多層膜を形成し、最後にp電極に平行な方向で、バーを切断してレーザ素子とする。

【0044】このレーザ素子をヒートシンクに設置し、それぞれの電極をワイヤーボンディングして、室温でレーザ発振を試みたところ、室温において連続発振を示し、単レーザ光のFFPは単一で、その形状も梢円形で形の良いものが得られていた。また、レーザ素子の特性

に関しても、我々がJpn. J. Appl. Phys. Vol. 36(1997)に発表したものに比較して、閾値が15%以上低下し、寿命は60%以上向上した。

【0045】【実施例2】実施例1において、n側クラッド層13を成長させる際に、Siドープn型A10.20Ga<sub>0.80</sub>N<sub>2</sub>5オングストロームと、アンドープGaN<sub>2</sub>5オングストロームを積層し、総膜厚1.0μmの超格子よりなるn側クラッド層13を成長させる他は同様にしてレーザ素子を作製した。なおn側クラッド層はA1平均組成が10.0%であるので、その膜厚との積は10.0である。このレーザ素子も実施例1とほぼ同等の特性を有していた。

【0046】【実施例3】実施例1において、n側クラッド層13を成長させる際に、Siドープn型A10.20Ga<sub>0.80</sub>N<sub>2</sub>5オングストロームと、アンドープGaN<sub>2</sub>5オングストロームを積層し、総膜厚0.7μmの超格子よりなるn側クラッド層13を成長させる他は同様にしてレーザ素子を作製した。n側クラッド層はA1平均組成が1.0%であるので、その膜厚との積は7.0である。このレーザ素子も実施例1とほぼ同等の特性を有していた。

【0047】【実施例4】実施例1において、n側クラッド層13を成長させる際に、Siドープn型A10.12Ga<sub>0.88</sub>N<sub>2</sub>5オングストロームと、アンドープGaN<sub>2</sub>5オングストロームを積層し、総膜厚0.8μmの超格子よりなるn側クラッド層13を成長させる他は同様にしてレーザ素子を作製した。n側クラッド層はA1平均組成が6.0%であるので、その膜厚との積は4.8である。このレーザ素子もFFPは実施例1と同等であり、Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 36(1997)に発表したものに比較して、閾値が8%以上低下し、寿命は30%以上向上した。

【0048】【実施例5】実施例1において、n側クラッド層18を成長させる際に、Siドープn型A10.07Ga<sub>0.93</sub>N層25オングストロームと、アンドープGaN層25オングストロームとを、総膜厚1.4μmで成長させる他は同様にして、レーザ素子を作製した。n側クラッド層は、A1平均組成が3.5%であるので、その膜厚との積は4.9である。このレーザ素子は実施例4のものとほぼ同等の特性を示した。

【0049】【実施例6】実施例1において、ストライプ状のリッジを形成する際、そのリッジ形状を図5に示すような形状とする。但し、図5において、両出力側のストライプ幅は2μmとし、中央部のストライプ幅は4μmとして、その傾斜角を5°以内に調整する。このレーザ素子も実施例1とほぼ等々の特性を示した。

【0050】【発明の効果】以上説明したように、本発明によると水平横モード、垂直横モード共にシングルモードが得られる。しかもレーザ光伸すスポット形状も単一な梢円とな

り、一定のFFPが得られる。窒化物半導体はサファイアという窒化物半導体よりも屈折率の小さい材料を使用するため、従来の問題は避けられないようと思われてきたが、本発明によりサファイアに限らず、窒化物半導体よりも屈折率の小さい、どのような基板の上にレーザ素子を作製しても、シングルモードで、きれいな形状のレーザ光が得られるため、書き込み、読みとり光源として、その利用価値は非常に大きい。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例に係るレーザ素子の構造を示す斜視図。 10

【図2】 図1のレーザ素子をリッジ上部から見た平面図。

【図3】 図1のレーザ素子にp電極を形成した後の構造を示す模式断面図。

【図4】 リッジストライプの形状を示す平面図。

【図5】 本発明に係るレーザ素子のリッジストライプの一形状を示す平面図。

【図6】 本発明に係るレーザ素子のリッジストライプの一形状を示す平面図。

【図7】 本発明に係るレーザ素子のリッジストライプ

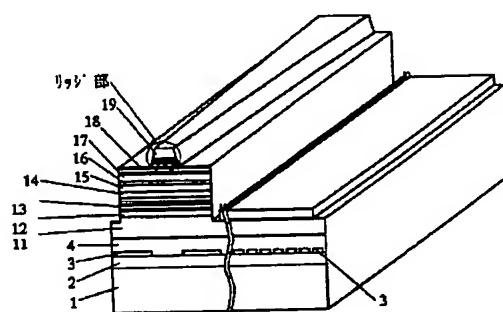
の一形状を示す平面図。

【図8】 従来のレーザ素子の構造を示す模式断面図。

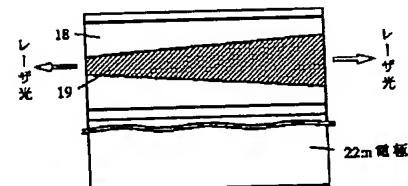
## 【符号の説明】

1	… 異種基板
2	… GaN下地層
3	… 保護膜
4	… 窒化物半導体基板
11	… n側バッファ層
12	… クラック防止層
13	… n側クラッド層
14	… n側光ガイド層
15	… 活性層
16	… p側キャップ層
17	… p側光ガイド層
18	… p側クラッド層
19	… p側コンタクト層
20	… p電極
21	… pパット電極
22	… n電極
23	… 絶縁膜

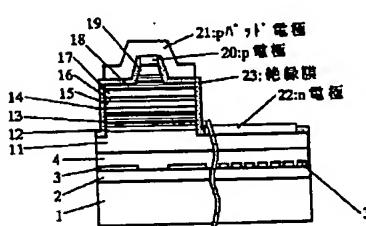
【図1】



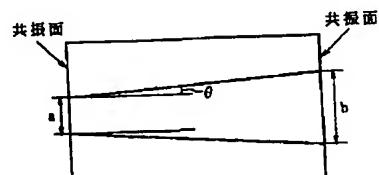
【図2】



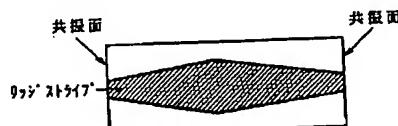
【図3】



【図4】

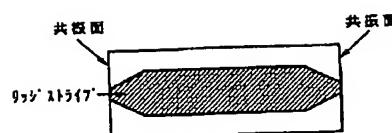


【図5】

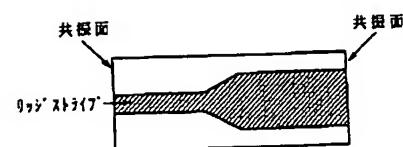


(9)

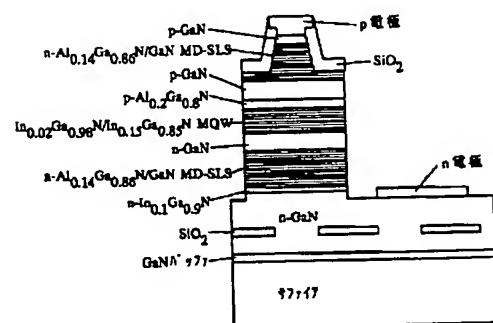
【図6】



【図7】



【図8】



BEST AVAILABLE COPY